








	<h2>SI7850DP-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7850DP-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI7850DP-T1-E3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 16540 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7850DP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16540 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 6.2A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 10.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7850DP-T1-E3DKR

SI7850DP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7850DP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7850DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7850DP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7850DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7850ADP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V POWERPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7852ADP</b> SI SI7852ADP SI</p>	 <p><b>SI7850DP-T1-E3.</b> VIS VIS QFN8</p>
 <p><b>SI7848DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 10.4A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7850DP</b> VISHAY SI7850DP VISHAY</p>	 <p><b>SI7850DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7848DP-T1-GE3</b> V SI7848DP-T1-GE3 V</p>

### heiße Teile

Mehr

SI7842DP-T1-E3	SI7842DP-T1-GE3	SI7842DP-T1-GE3	SI7844DP	SI7844DP-T1
SI7844DP-T1-E3	SI7844DP-T1-E3	SI7844DP-T1-GE3	SI7844DP-T1-GE3	SI7846DP
SI7846DP-T1-E3	SI7846DP-T1-E3	SI7846DP-T1-GE3	SI7846DP-T1-GE3	SI7846DP-TI
SI7846SAC	SI7848BDP-T1-E3	SI7848BDP-T1-E3	SI7848BDP-T1-GE3	SI7848BDP-T1-GE3
SI7848DP	SI7848DP-T1-E3	SI7848DP-T1-E3	SI7848DP-T1-GE3	SI7850DP
SI7850DP-T1-E3	SI7850DP-T1-GE3	SI7850DP-T1-GE3	SI7852ADP	SI7852ADP-T1-E3
SI7852ADP-T1-E3	SI7852ADP-T1-GE3	SI7852ADP-T1-GE3	SI7852DP	SI7852DP-T1-E3
SI7852DP-T1-E3	SI7852DP-T1-GE3	SI7852DP-T1-GE3	SI7856ADP	SI7856ADP-T1-E3
SI7856ADP-T1-E3	SI7856ADP-T1-GE3	SI7856ADP-T1-GE3	SI7856DP-T1	SI7856DP-T1-GE3
SI7856DP-T1-E3	SI7858ADP	SI7858ADP-T1-E3	SI7858ADP-T1-E3	SI7858ADP-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited